

國立高雄大學電機工程學系研究所

碩士論文

半導體新產品平面度預測能力提升之模型導入

Model Introduction to Improve the Coplanarity Prediction Capability of New Semiconductor Products

研究生：陳筠霈　撰

指導教授：吳東穎　博士

中華民國一一四年七月

# 

# 致謝

　　本論文之完成，首先向在研究歷程中給予指導與協助的諸位師長與夥伴表達最誠摯的感謝之意。

首先，衷心感謝本論文指導教授吳東穎教授，在整個研究過程中提供指導與寶貴意見。教授在學術研究上的專業與嚴謹態度，對本人產生深遠之影響，無論於研究設計、資料分析，乃至論文撰寫皆有莫大助益，實為本論文能順利完成之重要推手。

同時，向施明昌教授表達誠摯感謝。教授於研究方法與實務應用方面所提供之建議，使本研究更臻完善，其專業見解與教誨令本人獲益良多。

亦感謝黃鈺珊學姐於研究初期提供經驗分享與技術協助，對資料整理與研究方向的釐清，提供了極具價值的建議，使研究工作得以順利推進。

此外，感謝同儕陳奕齊同學在研究過程中的協助與學術交流討論，是本研究過程中不可或缺的重要助力。

在此向所有曾給予本人協助與支持的師長、先進與同儕致上誠摯謝意，並深深銘記於心。

**半導體****新產品平面度預測能力提升之模型導入**

指導教授 : 施明昌 博士

國立高雄大學電機工程系碩士班

學生 : 陳筠霈

國立高雄大學電機工程研究所

# 摘要

　　在科技快速演進的時代，半導體產業於新產品導入(NPI) 階段扮演關鍵角色，需針對產品結構、材料及製程參數進行準確預測。其中，晶片的平面度是影響電路連接品質與元件穩定性的核心指標。目前常見的預測方式多仰賴人工經驗與實驗室測試，但面對製程條件的高度變異性與非線性影響因素，此類方法難以達到預期精度，即使引入實驗設計(DoE) 方式，仍僅有約 11% 的產品件數符合小於15um 的誤差規格。平面度不良(Coplanarity Fail) 將導致上板成功率降低、重工增加及出貨延遲，造成生產效率與成本的雙重損失。本研究提出結合人工智慧AI與機器學習的解決方案，導入Gradient Boosting、Lasso Linear、Random Forest與Support Vector Machines四種演算法，進行共323筆樣本資料的訓練，針對24個關鍵因子依照結構、材料與製程三大方向進行分析。結果顯示，本研究能有效將預測誤差控制在15um以內的比例提升至71%，大幅超越傳統方法的表現，不僅能大幅減少預測成本，亦能提升良率與出貨效率，實現高成本效益與生產穩定性。

關鍵字：NPI、平面度、預測、機器學習

**Model Introduction to Improve the Coplanarity Prediction Capability of New Semiconductor Products**

Advisor: Dr. Ming-Chang Shih

Institute of Electrical Engineering

National University of Kaohsiung

Student: Yun-Pei Chen

Institute of Electrical Engineering

National University of Kaohsiung

ABSTRACT

In the era of rapid technological advancement, the semiconductor industry plays a critical role during the New Product Introduction (NPI) phase, requiring accurate predictions regarding product structure, materials, and process parameters. Among these, chip coplanarity is a key indicator affecting circuit connectivity and component stability. Traditional prediction methods often rely on human expertise and laboratory testing, however, due to the high variability and nonlinear interactions within process conditions, these methods frequently fail to meet the required accuracy. Even with the implementation of Design of Experiments (DoE), only about 11% of products meet the error specification of less than 15μm. Coplanarity failures lead to reduced assembly success rates, increased rework, and shipment delays, resulting in decreased production efficiency and increased costs. This study proposes a solution that integrates Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning by applying four algorithms: Gradient Boosting, Lasso Linear, Random Forest, and Support Vector Machines. A total of 323 samples were trained and analyzed based on 24 key factors grouped into three main categories: structure, materials, and process. The results demonstrate that this approach significantly improves prediction accuracy, raising the proportion of predictions within the 15μm error tolerance to 71%. Compared to traditional methods, this model not only reduces prediction costs but also enhances yield and delivery efficiency, achieving greater cost-effectiveness and production stability.

**Keywords :** NPI, Coplanarity, Prediction, Machine Learning

# 目錄

[致謝 I](#_Toc172908149)

[摘要 II](#_Toc172908150)

[ABSTRACT III](#_Toc172908151)

[目錄 V](#_Toc172908152)

[圖目錄 VII](#_Toc172908153)

[表目錄 IX](#_Toc172908154)

[第一章 緒論 1](#_Toc172908155)

[1-1前言 1](#_Toc172908156)

[1-2研究動機 1](#_Toc172908157)

[1-3研究架構 1](#_Toc172908158)

[第二章 基礎理論與文獻回顧 3](#_Toc172908159)

[2-1研磨製程介紹 3](#_Toc172908160)

[2-1-1研磨目的 4](#_Toc172908161)

[2-1-2研磨標準流程 4](#_Toc172908162)

[2-1-3三軸加工特性 5](#_Toc172908163)

[2-1-4研磨加工種類 8](#_Toc172908164)

[2-1-5影響研磨要因 10](#_Toc172908165)

[2-1-6研磨指標介紹 13](#_Toc172908166)

[2-2研磨輪介紹 13](#_Toc172908167)

[2-2-1研磨輪結構 14](#_Toc172908168)

[2-2-2結構主要元素 14](#_Toc172908169)

[2-2-3 砥粒種類 15](#_Toc172908170)

[2-3拋光製程種類介紹 16](#_Toc172908171)

[2-3-1CMP(Chemical Mechanical Polishing) 16](#_Toc172908172)

[2-3-2 DP(Dry Polishing) 17](#_Toc172908173)

[2-3-3DPEG(Dry Polish Extrinsic Gettering) 18](#_Toc172908174)

[2-4DPEG製程常見缺點 19](#_Toc172908175)

[2-4-1晶圓焦黑(Wafer Burning) 19](#_Toc172908176)

[2-4-2晶圓破片(Wafer Broken)及邊緣破損(Edge Chipping) 20](#_Toc172908177)

[2-4-3 拋光不完全 21](#_Toc172908178)

[2-5銅離子擴散 22](#_Toc172908179)

[2-5-1銅離子來源 22](#_Toc172908180)

[2-5-2銅離子影響 22](#_Toc172908181)

[2-5-3吸附層(Gettering Side) 22](#_Toc172908182)

[2-5-4內部吸附(Intrinsic Gettering) 23](#_Toc172908183)

[2-5-5外部吸附(Extrinsic Gettering) 23](#_Toc172908184)

[第三章 現況問題與實驗方法 26](#_Toc172908185)

[3-1DPEG製程現況 26](#_Toc172908186)

[3-1-1機台現行參數 26](#_Toc172908187)

[3-1-2膠膜使用 27](#_Toc172908188)

[3-1-3工作盤角度 28](#_Toc172908189)

[3-2儀器與設備 29](#_Toc172908190)

[3-2-1研磨機(DGP8761) 29](#_Toc172908191)

[3-2-2拋光輪(DPEG) 30](#_Toc172908192)

[3-2-3膠膜(340HV/440HBA) 31](#_Toc172908193)

[3-2-4被加工物(Dummy Wafer) 32](#_Toc172908194)

[3-2-5機台參數說明 32](#_Toc172908195)

[3-3田口實驗法 33](#_Toc172908196)

[3-3-1直交表 34](#_Toc172908197)

[3-3-2訊號雜音比(S/N) 34](#_Toc172908198)

[3-3-3變異數分析(ANOVA) 35](#_Toc172908199)

[3-3-4加法模式預測 37](#_Toc172908200)

[3-4實驗流程 37](#_Toc172908201)

[3-5實驗設計 38](#_Toc172908202)

[3-5-1特性要因分析 38](#_Toc172908203)

[3-5-2關鍵因子及水準配置 40](#_Toc172908204)

[3-5-3直交表設計 41](#_Toc172908205)

[第四章 實驗結果與驗證 42](#_Toc172908206)

[4-1 數據計算 42](#_Toc172908207)

[4-2 S/N比反應圖表分析 42](#_Toc172908208)

[4-3各因子變異數分析 43](#_Toc172908209)

[4-4最佳參數加法模式預測 43](#_Toc172908210)

[4-5參數最佳化驗證 44](#_Toc172908211)

[4-6實際導入驗證 45](#_Toc172908212)

[第五章 結論與建議 48](#_Toc172908213)

[第六章 參考文獻 49](#_Toc172908214)

# 圖目錄

[圖 1‑1 研究架構圖 2](#_Toc172908215)

[圖 2‑1 研磨製程步驟圖 3](#_Toc172908216)

[圖 2‑2 研磨製程種類圖 3](#_Toc172908217)

[圖 2‑3 Z1/Z2/Z3粗糙度差異圖 4](#_Toc172908218)

[圖 2‑4 研磨標準流程圖 4](#_Toc172908219)

[圖 2‑5 Z1/Z2/Z3磨耗示意圖 5](#_Toc172908220)

[圖 2‑6 粗研磨輪(左)、細研磨輪(右) 5](#_Toc172908221)

[圖 2‑7 粗磨作業及研磨量示意圖 6](#_Toc172908222)

[圖 2‑8 細磨作業及研磨量示意圖 6](#_Toc172908223)

[圖 2‑9 拋光作業示意圖 7](#_Toc172908224)

[圖 2‑10 Z1/Z2/Z3實際加工後示意圖 7](#_Toc172908225)

[圖 2‑11 Z1/Z2/Z3紋路示意圖 7](#_Toc172908226)

[圖 2‑12 Z1與Z2表面粗糙度比較圖 8](#_Toc172908227)

[圖 2‑13 深進緩給研磨示意圖 8](#_Toc172908228)

[圖 2‑14 軸向進給研磨示意圖 9](#_Toc172908229)

[圖 2‑15 軸向進給作業流程圖 9](#_Toc172908230)

[圖 2‑16 砥粒大小影響示意圖 11](#_Toc172908231)

[圖 2‑17 砥粒數量影響示意圖 11](#_Toc172908232)

[圖 2‑18 主軸轉速影響示意圖 12](#_Toc172908233)

[圖 2‑19 工作盤轉速影響示意圖 12](#_Toc172908234)

[圖 2‑20 主軸下降速度影響示意圖 12](#_Toc172908235)

[圖 2‑21 研磨輪結構圖 14](#_Toc172908236)

[圖 2‑22 結構主要元素示意圖 14](#_Toc172908237)

[圖 2‑23 硬度比較圖 15](#_Toc172908238)

[圖 2‑24 氣孔示意圖 15](#_Toc172908239)

[圖 2‑25 CMP示意圖 16](#_Toc172908240)

[圖 2‑26 CMP阻塞示意圖 16](#_Toc172908241)

[圖 2‑27 DP研磨輪 17](#_Toc172908242)

[圖 2‑28 DP實際粗糙度圖 17](#_Toc172908243)

[圖 2‑29 拋光作業流程圖 18](#_Toc172908244)

[圖 2‑30 DPEG研磨輪 18](#_Toc172908245)

[圖 2‑31 DPEG實際粗糙度圖 19](#_Toc172908246)

[圖 2‑32 晶圓焦黑圖 19](#_Toc172908247)

[圖 2‑33 焦黑示意圖 20](#_Toc172908248)

[圖 2‑34 晶圓破片圖(左)、邊緣破損圖(右) 20](#_Toc172908249)

[圖 2‑35 拋光不完全圖 21](#_Toc172908250)

[圖 2‑36 銅離子擴散示意圖 22](#_Toc172908251)

[圖 2‑37 吸附層示意圖 23](#_Toc172908252)

[圖 2‑38吸附層預防銅離子擴散圖 23](#_Toc172908253)

[圖 2‑39 內部吸附示意圖 23](#_Toc172908254)

[圖 2‑40 外部吸附層示意圖 24](#_Toc172908255)

[圖 2‑41 外部吸附層因拋光製程移除示意圖 24](#_Toc172908256)

[圖 2‑42 吸附作用示意圖(未拋光) 24](#_Toc172908257)

[圖 2‑43吸附作用示意圖(已拋光) 25](#_Toc172908258)

[圖 2‑44 有吸附/未吸附示意圖 25](#_Toc172908259)

[圖 2‑45 DPEG與DP銅離子游離比較圖 25](#_Toc172908260)

[圖 3‑1 機台現行作業參數圖 26](#_Toc172908261)

[圖 3‑2 DPEG製程缺點示意圖 26](#_Toc172908262)

[圖 3‑3 DPEG製程缺點示意圖 27](#_Toc172908263)

[圖 3‑4 DPEG膠膜(440)壓力數值圖 27](#_Toc172908264)

[圖 3‑5 DPEG工作盤角度(30°)電流數值圖 28](#_Toc172908265)

[圖 3-6 現行DPEG機台電流值圖 28](#_Toc172908266)

[圖 3‑7 DGP8761 29](#_Toc172908267)

[圖 3‑8 DPEG清洗落塵示意圖 30](#_Toc172908268)

[圖 3‑9 圓錐體工作盤示意圖 30](#_Toc172908269)

[圖 3‑10 DPEG拋光輪 31](#_Toc172908270)

[圖 3‑11 340/440膠膜比較圖 31](#_Toc172908271)

[圖 3‑12 此次實驗用dummy wafer 32](#_Toc172908272)

[圖 3‑13 實驗流程圖 38](#_Toc172908273)

[圖 3‑14 特性要因魚骨圖 39](#_Toc172908274)

[圖3-15 各因子影響DPEG拋光製程比例 40](#_Toc172908275)

[圖 4‑1 DPEG膠膜(340)壓力數值圖 46](#_Toc172908276)

[圖 4-2 30°傾角及60°傾角排屑示意圖 46](#_Toc172908277)

[圖 4-3 60°傾角作業電流圖 47](#_Toc172908278)

[圖 4-4 30°傾角作業電流圖 47](#_Toc172908279)

# 表目錄

[表 3-1 程式參數表 32](#_Toc172908280)

[表 3-2 Z3拋光製程參數表 33](#_Toc172908281)

[表 3‑3 ()直交表 34](#_Toc172908282)

[表 3‑4　關鍵因子及水準配置表 40](#_Toc172908283)

[表 3‑5　因子參數組合配置表 41](#_Toc172908284)

[表 4‑1　實驗之S/N比及表面粗糙度平均值 42](#_Toc172908285)

[表 4‑2　因子S/N比反應表 42](#_Toc172908286)

[表 4‑3　S/N比反應圖 43](#_Toc172908287)

[表 4‑4　各因子變異數分析表 43](#_Toc172908288)

[表 4-5最佳參數加法預測結果比較 44](#_Toc172908289)

[表 4-6最佳參數驗證實驗結果表 45](#_Toc172908290)

[表 4-7實際效益表 45](#_Toc172908291)

# 第一章 緒論

## 1-1前言

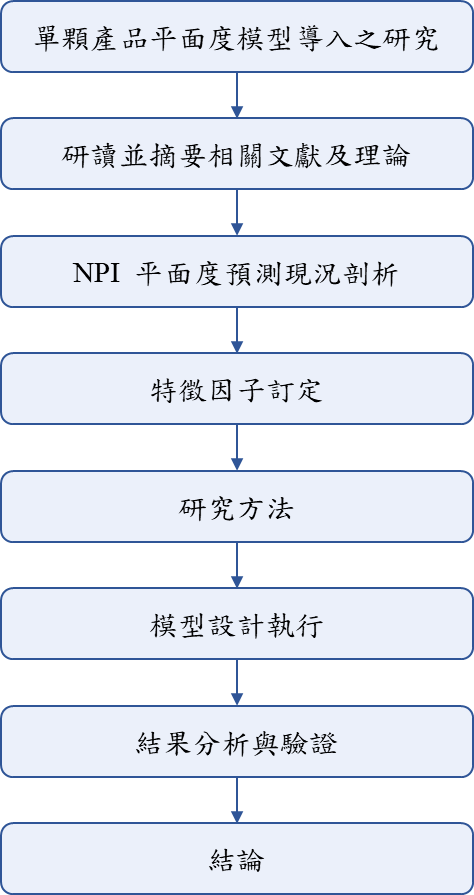
　　在當今科技迅速發展的背景下，半導體產業在現代電子產品的發展中扮演著舉足輕重的角色。不僅是電子設備的核心組成部分，還對許多新興領域，如物聯網、人工智慧和無人駕駛汽車等產業的發展起到了推動作用。而隨著新產品不斷推陳出新，如何確保產品的高品質和高性能成為一個日益重要的挑戰。新產品導入階段，涉及對產品結構、材料及參數的全面設計、驗證和測試，除避免時間和資源的耗費，因應市場需求的多樣化和技術的快速更迭，必需確保新產品能夠快速適應並達到高標準。

## 1-2研究動機

　　製程中，平面度作為晶片表面平整度的關鍵指標，對產品的電路連接性及元件穩定性至關重要。然而，在新產品導入初期，現階段的平面度因子預測往往依賴傳統的人工經驗，由於製程條件的多變性和複雜性，往往無法完全捕捉到各種影響因素之間的非線性關聯，從而導致預測誤差較大，造成後續製程上引發不良品，影響產品品質，並延誤整體出貨時間，對生產效率造成負面影響。在過去十年中，隨著製程自動化和智能化的推進，產業漸漸邁向數據驅動的時代，其中機器學習技術的發展，運用其強大的數據處理和模式識別能力，已成為解決這一問題的有效方法。機器學習模型能夠自動從大量的歷史數據中學習，捕捉製程影響因子和平面度之間的複雜關聯。本論文旨在探討，如何運用模型的導入來降低預測誤差值，達到符合的規格，並提供可靠性的預測結果，為製程減少成本及時間，為半導體製造技術的進一步發展。

## 1-3研究架構

　　本論文研究架構如下圖1-1



# 第二章 基礎理論與文獻回顧

## 2-1半導體製程與平面度的概念

### 2-1-1半導體製程概述

　　半導體製程是將基礎材料轉換為具有特定功能的電子元件過程。這個過程通常由幾個主要步驟組成，首先是晶圓的準備，包括晶圓的切割、清潔和薄化。接下來是形成半導體結構的步驟，這些結構通過光刻、蝕刻、薄膜沉積、離子植入等技術形成，並且通常會進行多次迭代以實現最終的設計要求[1]。

隨著半導體技術的進步，特別是向微型化和高密度集成電路的方向發展，每一個製程步驟的精度要求變得越來越高，這樣的變化對製程中的每個環節，尤其是平面度控制，提出了更高的挑戰。

製程中的平面度問題，往往會影響光刻的對準精度和微結構穩定性，進而影響最終產品的良率。對於現代半導體製程來說，平面度不僅僅是結構的幾何要求，還與材料的均勻性、參數的條件因子、應力分佈及後續步驟的精度有著密切關聯。因此，半導體製程的每一個步驟都需要精確控制，才能確保產品的高性能與穩定性。

### 2-1-2平面度定義與對製程影響

平面度是指半導體製程中，晶片或封裝元件表面與理想平面之間的偏差，通常以表面高度差來衡量。這種偏差可能來自於多種原因，例如製程過程中的熱應力、機械壓力、材料的不均勻性或過度沉積等。在半導體製程中，若平面度控制不當，將對光刻、薄膜沉積、蝕刻等步驟造成不良影響，進而影響微結構的形狀和尺寸，最終影響器件的性能和可靠性。特別是在先進製程中，隨著技術要求的提高，對平面度的精確控制變得尤為重要。例如，極紫外光(EUV) 光刻技術要求的精度遠超過傳統光刻技術，任何平面度上的微小偏差都可能導致微結構對準誤差，從而影響製程的穩定性和產品的合格率。因此，對於先進的半導體製程而言，精確的平面度控制是保證高良率和高性能的基礎。

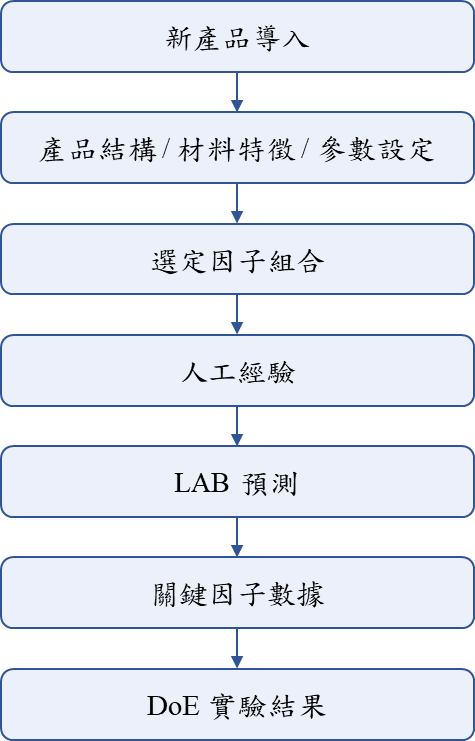
此外，平面度對半導體封裝中的焊接質量也至關重要。封裝過程中，平面度指的是元件的引腳、接點或表面相對於基板的平坦度。若引腳或接點的高度超出理想範圍，即為共面性偏差(Coplanarity Deviation)，這將影響焊接過程中引腳與焊料的接觸，可能導致焊接不良或電路開路，從而影響到最終產品的功能表現，甚至可能導致設備失效。隨著封裝尺寸的縮小和引腳間距的減少，平面度控制的要求也越來越高，尤其是在表面安裝技術(SMT) 中[5]。

不良的平面度會降低焊接質量，進而導致產品不合格，甚至大量報廢，增加製造成本。因此，對平面度的精確控制，不僅能提高產品的質量，還能提升生產效率，減少不必要的資源浪費。在現代半導體製程中，平面度的監控和調整變得愈加複雜，但其重要性卻越來越突出，對產品良率和生產成本有著直接的影響。

## 2-2現況新產品平面度的預測

### 2-2-1傳統預測的方法與局限性

　　傳統的平面度預測方法主要依賴過往人工經驗與實驗室測試來進行預測。雖然這些方法能提供一定的指導價值，但隨著半導體製程越來越複雜及新產品的多樣化，其預測的精確性與適用性逐漸面臨挑戰。特別是在新材料引進和製程條件不斷變化的情況下，傳統方法的預測誤差較大，難以滿足現代製程對精度的要求。



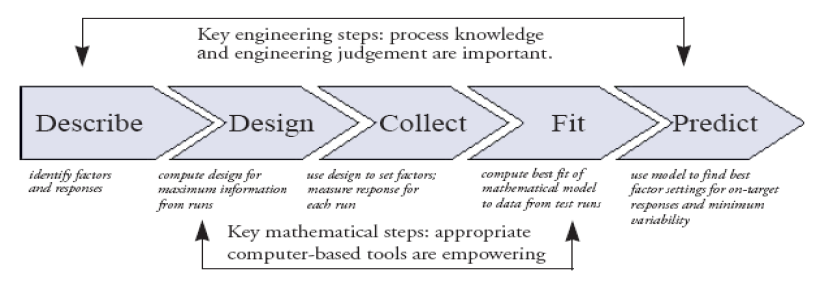
這些數據是根據結構、材料和製程參數因子做預測方法的基礎分析。半導體元件的設計、選擇及條件，都會顯著影響平面度。材料的熱膨脹係數、機械強度與流動性，會直接影響製程中的變形情況，而結構設計的複雜性及元件厚度等因素同樣會對平面度產生重要影響。此外，製程中的溫度、壓力等變數也會改變表面形態的均勻性，進而影響最終的平整度。因此，準確分析這些因素之間的相互關係，是平面度預測的關鍵。然而，這些分析往往只能提供大致的預測結果，對於許多複雜的製程來說，這些方法無法達到足夠的準確性，導致預測誤差較高。

簡單製程或已知條件下，人工經驗可在傳統預測方法中扮演著關鍵角色。當製程條件較為相似時，過往的經驗可以幫助工程師快速估算。然而，當新產品的設計、材料或製程條件發生變化時，僅依賴人工經驗常常無法提供精確的預測。

也隨著半導體製程的複雜性增加，這些方法的預測誤差逐漸變得更加顯著。儘管實驗室測試能提供一定的數據支持，但由於測試過程受限於實驗條件，其結果的適用範圍有限。特別是在實際生產中，這些傳統方法無法快速且準確地應對多變的製程環境。因此，對這些方法進行改進，已成為提升平面度預測精度的關鍵挑戰。在此背景下，實驗設計(DoE) 方法被引入，為探索製程參數如何影響平面度提供了更系統化的方式，並且能進一步優化製程，提高預測準確性。

### 2-2-2實驗設計(Design of Experiments, DoE) 方法的應用與挑戰

為了提高平面度預測的準確性，DoE方法被引入到半導體製程的預測中。DoE是一種利用統計學原理來設計、執行和分析實驗的方法。



整體理念是通過系統性的變化製程參數，如溫度、壓力、材料種類等，來觀察這些變數對平面度的影響。這種方法能夠幫助工程師有效地收集數據，找出最佳的製程條件，從而提升平面度的預測精度。DoE的核心優勢在於它能夠通過少量的實驗設計來獲得多維度的數據，從而確定各個製程變數對平面度的貢獻程度，進一步優化製程參數。

通過DoE方法，工程師可以針對不同的製程參數組合，設計實驗並收集大量數據，這有助於全面了解不同變數如何交互作用並影響最終的平面度。例如，在一個實驗設計中，工程師可能會選擇調整材料的厚度、製程溫度及壓力，並測量每一組合下的表面高度差。這樣通過對數據的統計分析，可以揭示出哪些參數對平面度有最直接的影響，從而提供一個更為科學的預測基礎。

然而，儘管DoE方法能夠提供更精確的預測，並幫助工程師更好地理解製程參數與平面度之間的關聯，但它也有其局限性。首先，DoE方法本身對時間和成本的要求較高，尤其是在面對多變數的情況下，實驗組合數量將顯著增加，這將消耗大量的時間、材料和人工成本，以現今估算出的成本，待DoE實驗結果平均時間為一個月，材料採購的等待時間平均為三個月，而花費的材料成本又得依工程師經驗去選擇。

其次，DoE的預測結果也可能受到實驗條件設計的限制，若設計不當，可能會導致對某些關鍵變數的影響，估計不足，從而降低預測精度。加上DoE方法對於非線性關係和高階交互作用的處理能力仍然有限，尤其是在製程變數之間存在高度非線性或多重交互作用的情況下，DoE的預測效果可能會受到影響。

總體而言，雖然DoE能夠有效提升平面度預測的準確性並提供可靠的數據支持，但其在時間、成本及複雜度上的挑戰，仍然是許多半導體製程應用中的一大瓶頸。因此，若未來在進行平面度預測時，如何將DoE與其他先進的數據分析技術，如機器學習、深度學習等結合，將可能進一步提升預測的精度與效率，並克服現有方法的不足。

## 2-3 AI於產業應用帶來之效益

隨著AI技術的發展，半導體產業迎來了顯著的變革，AI在提升製程效率、品質控制、設計創新和預測模擬等方面發揮了重要作用[13]。

根據業界數據，AI能使半導體製程的生產效率提高約20%至30%。在品質檢測中將傳統人工檢測的缺陷漏檢率降至不到0.5%。在設計與研發方面，縮短了約20% 至30% 的設計周期，提高了設計準確性和效率，減少了重複設計的時間。在預測模擬成本控制方面同樣顯示出顯著效果，據報告顯示，AI能將生產成本降低10%至15%，這主要來自於AI技術通過學習和分析製程數據，導入的自動參數優化，從而降低生產中斷的風險。

總體而言，AI在半導體產業的應用有效提升了生產效率、品質控制、研發創新及預測模擬成本管理，帶來顯著的數字效益，並在未來持續創造更多的商業價值。

### 2-3-1結合機器學習(Machine Learning, ML)

機器學習作為一種基於數據驅動的預測方法，已廣泛應用於半導體製程中多項模型建置與參數優化。相較於傳統工程模擬技術，機器學習能夠在龐大且複雜的資料中萃取出隱含的非線性關係，提升預測精度與模型的泛化能力。

但許多於工程模擬軟體和技術的研發，都專於特定領域，例如，ANSYS可配合DoE方法進行製程模擬分析，並有效節省時間與成本，然而隨著製程技術的快速演進，產品結構與封裝材料日益多樣化，這也使得傳統物理模型在某些特殊情境下難以準確捕捉實際現象，進而限制其在實際場域的應用效益與模型效能評估[21]。

根據文獻指出，當引入機器學習方法後，可透過不同模型架構對特定預測問題進行比較分析，藉此辨別各模型對目標變數的敏感度與預測穩定性。更重要的是，這些模型可進一步套用於未曾見過的測試數據中，檢驗其泛化能力，凸顯了機器學習在預測中扮演了關鍵角色[8]。

也根據其他多個文獻指出，機器學習演算法已廣泛應用於預測半導體材料、參數與製程中所面臨的各類問題，皆提到監督式學習帶來的準確性，其中包含梯度提升技術(Gradient Boosting)、線性迴歸(Linear Regression)、隨機森林​​(Random Forest​​)、支援向量機​(Support Vector Machine​​) 。這些模型不僅適用於處理高維度、具多變數交互作用的資料，亦可針對不同預測目標進行客製化調整與訓練，並藉由特徵重要性排序分析，協助工程師理解各輸入因子對最終製程品質之影響程度[29][22][30]。

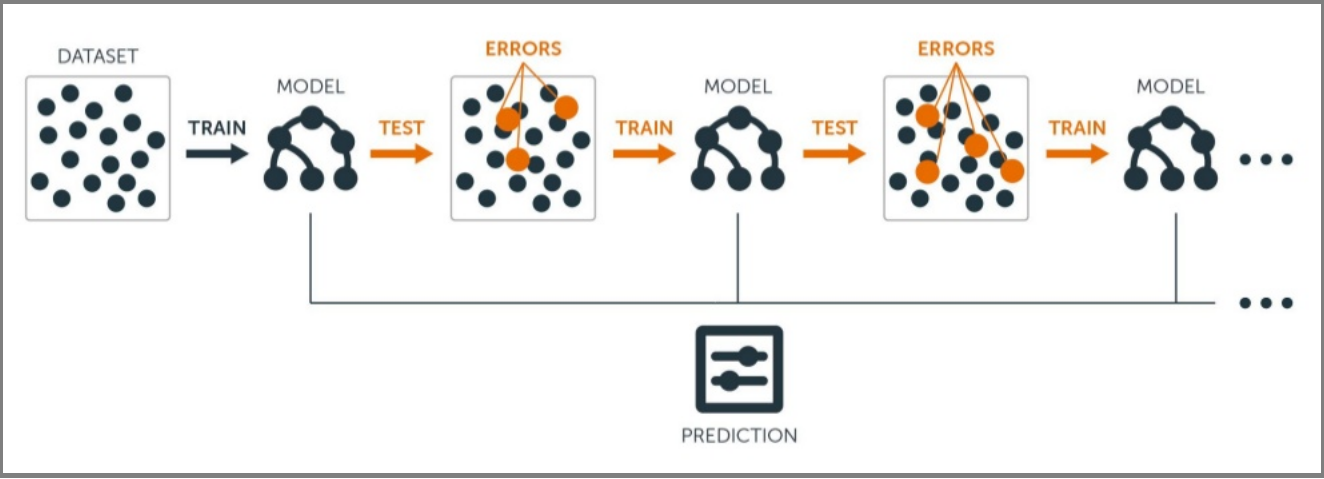
回歸研究，平面度預測也面臨其中的挑戰，為提升結果的準確度，本研究透過上述演算法來進行高精度的預測，並且能夠處理複雜的多維度數據。

## 2-4 機器學習演算法

　　透過採用多種演算法，有助於互補各自的弱點與局限，不僅能具備處理各種特徵資料的靈活性，也能在追求預測準確度的同時，兼顧運算資源與效率的平衡。[23]。

### 2-4-1梯度提升技術(Gradient Boosting)

Gradient Boosting核心主要透過疊代地結合多個弱學習器，通常是淺層決策樹(Shallow decision tree) 來形成一個強學習模型，是一種序列性集成學習(Ensemble Learning) 方法。其概念源自於提升(Boosting) ，即每一輪模型的建立都著重於修正前一輪模型無法正確預測的部分，以達到漸進式提升整體預測效能的目的[36]。



序列式(Sequential) 結構，採用逐步加法模型(Additive Model) 與梯度下降法(Gradient Descent) 進行損失函數的最小化，在初始模型上預測目標變數，並根據預測結果與實際值計算殘差，即誤差，以此方向作為新一輪模型訓練的最佳修正，將新模型加權納入整體預測當中，直到達到設定的疊代次數或誤差收斂為止[35]。

1. 加法模型(Additive Model)

* 透過逐步加入決策樹的方式來降低預測誤差
* 每次新增一棵樹，不會修改既有模型結構，而是累加誤差的修正結果
* 也可透過調整參數來進一步減少錯誤率

1. 弱學習器(Weak Learner)

* 是梯度提升進行預測的基礎，多採用回歸樹
* 每棵樹會尋找最佳切割點來建立，經多次疊代，能形成強大預測模型

1. 損失函數(Loss Function)

* 衡量預測錯誤並持續優化模型
* 梯度提升不會增加錯誤樣本的權重，而是利用損失函數的梯度作為修正方向
* 弱學習器的結果透過平均輸出來減少整體損失



### 2-4-2線性迴歸(Linear Regression)

Linear Regression是一種基本且廣泛應用的監督式學習方法，於建模自變數輸入與因變數輸出之間的線性關係，其假設為輸出變數可表示為輸入特徵的線性組合，加上一個常數項與誤差項。透過最小平方法(Least Squares Method) 來估計回歸係數，使預測值與實際觀測值之間的平方誤差總和最小。



簡單線性迴歸僅考慮單一輸入特徵，當資料中包含過多特徵，或特徵之間存在高度相關性時，模型容易出現過擬合現象，導致在新資料上的預測能力下降，而多元線性迴歸則可處理多變數情況。為了解決此問題，進一步的延伸方法Lasso Regression (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)。

Lasso Regression (Lasso Linear) 是帶有正則化項的線性模型，其目標函數在傳統的最小平方誤差中加入L1正則化(L1 regularization) 項，並對模型參數的絕對值加以懲罰，使部分不重要的特徵權重縮小至零，達到自動刪除不重要特徵的效果。



* ∥*y*−*Xβ*∥2 : 為傳統的平方誤差項
* ∥*β*∥1​ : 為所有迴歸係數的絕對值總和
* λ : 為正則化強度參數，控制懲罰項對模型的影響力，當 λ 越大，模型越偏向簡化，會刪除更多不具代表性的特徵



### 2-4-3隨機森林(Random Forest)

Random Forest基本概念是結合多棵獨立的決策樹(Decision Trees)，並將這些預測結果進行整合，透過多數決(分類) 或平均值(回歸)，以提升整體模型的準確性與穩定性。是一種廣泛應用於分類與迴歸問題的集成學習演算法，屬於Bagging(Bootstrap Aggregating) 架構的延伸與強化形式，其最大特點在於結合資料抽樣與特徵抽樣兩種隨機策略，有效降低了模型的過擬合風險，並提升了泛化能力。

並行式(Parallel) 結構，由於每棵樹都是獨立在不同的多次有放回的抽樣(bootstrap) 與特徵子集上建構，在分裂節點選擇時，從所有特徵中隨機判斷一部分作為候選特徵，再從中挑選最佳分裂依據。每棵樹彼此間不存在資料或運算上的相依性，因此在處理大量資料時能大幅提升運算效率與擴展性，架構設計使Random Forest適合在分散式運算環境中進行部署，大幅縮短模型訓練時間。

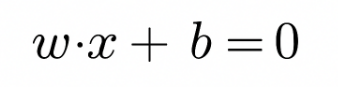
除了訓練階段，預測階段亦可透過將輸入資料分配至多顆樹平行運算來加速預測流程，對於分類問題，收集所有樹對某筆輸入資料的分類結果，並以多數投票方式決定最終類別；對於迴歸問題，則是對所有樹的預測值取平均，作為最終輸出。這種集體決策機制在統計上有效減少了模型的變異性，保留其穩健與高準確度的優勢。此外，Random Forest具備自我驗證機制，可透過未被抽樣到的資料(Out-of-Bag data) 進行模型準確度評估，無需額外切分驗證集，提升了資料的利用效率，也展現高度的計算靈活性，適用於大規模資料分析與實務工業應用。



### 2-4-4支援向量機(Support Vector Machine, SVM)

SVM是一種監督式學習模型，廣泛應用於分類與迴歸問題中，其核心概念為尋找一條最佳的超平面(hyperplane) 以區分不同類別的資料點。

可線性分割的資料，SVM嘗試找到一條能使兩類資料點之間間距(margin) 最大化，以此提升模型的泛化能力，並滿足以下條件。



支援向量指的是位於邊界上、對超平面位置有決定性影響的資料點，而模型訓練的目標即為最大化這些支援向量與超平面之間的間距，從而達到穩健的分類效果。

不可線性分割的資料，SVM 引入了核函數(kernel function) 的概念，透過非線性映射將原始資料投影到高維空間，使其在新空間中具有線性可分性。常見的核函數包括高斯徑向基核(Radial Basis Function, RBF)、多項式核(Polynomial kernel) 與Sigmoid核。透過選擇合適的核函數與調整相關參數，能夠有效處理非線性與複雜資料結構，維持高分類精度。

SVM採用拉格朗日乘數法(Lagrangian Multipliers)，優化每個樣本的分類約束，模型訓練過程中會將原始的約束最小化問題轉換為對偶問題，進而提高運算效率。透過硬間距(hard margin) 與軟間距(soft margin) 設計，可根據資料雜訊程度調整容錯空間，避免過度擬合，並提升對未見資料的預測能力。



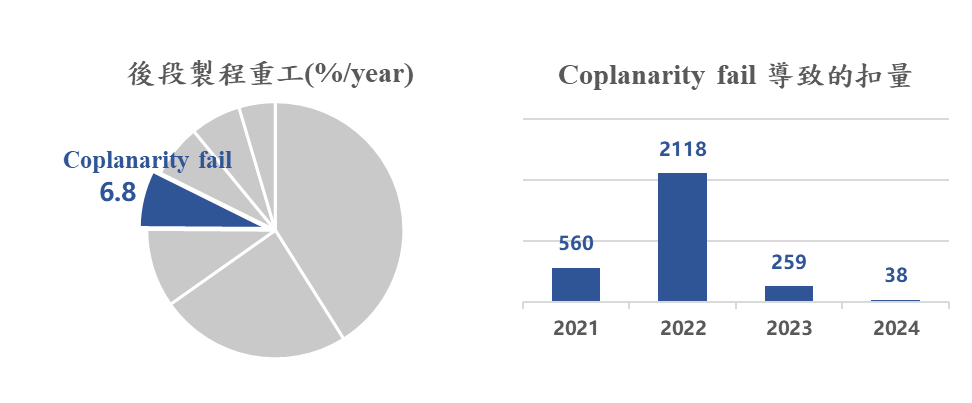
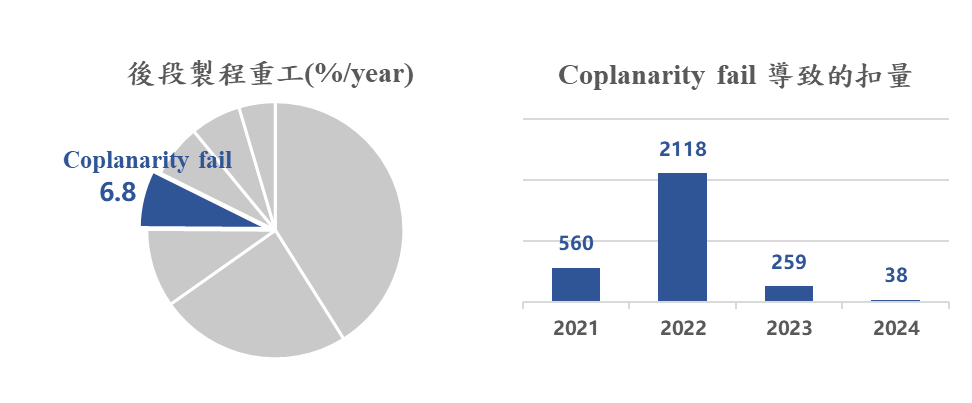
# 第三章 現況問題與模型設計

## 3-1製程問題情境

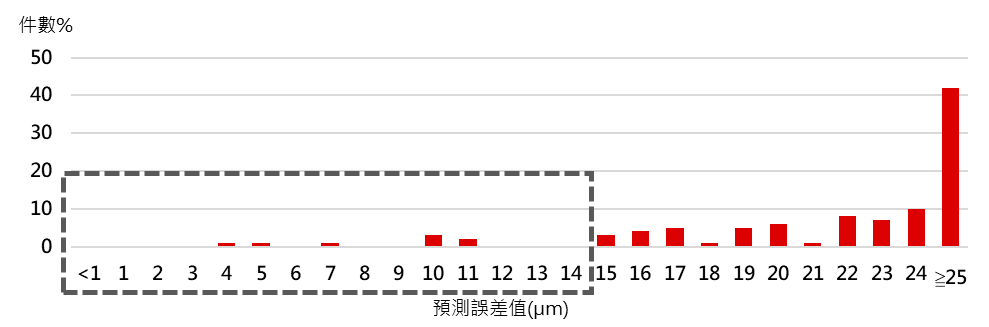
　　外界若溫度變化，物理性質上會產生熱漲冷縮的現象，因與物體本身熱膨脹係數(CTE) 密切相關。

廠內產品在後段封裝過程中，晶片(Die/Chip) 與基板(Substrate) 不同材料之間的 CTE Mismatch、參數組合的差異，加上含膠的限制，為了釋放溫度所產生的內部應力，常藉由形狀改變來釋放這些內力，導致產品平面度不良(Coplanarity fail)，進而影響後續上板成功率、出貨時間。

製程重工 Coplanarity fail 每年就佔了所有的 6.8%。



現行符合客戶預測誤差值規格需小於15um，然而使用傳統方式，多次預測結果仍有過大誤差可能，在非指定產品NPI導入時僅有11% 符合規格。



## 3-2 KPI指標

透過AI模型之導入，降低預測的誤差值，為本研究目標，並縮減因子範圍，進而減少額外生成的成本及實驗結果時間，實現更高成本效益。

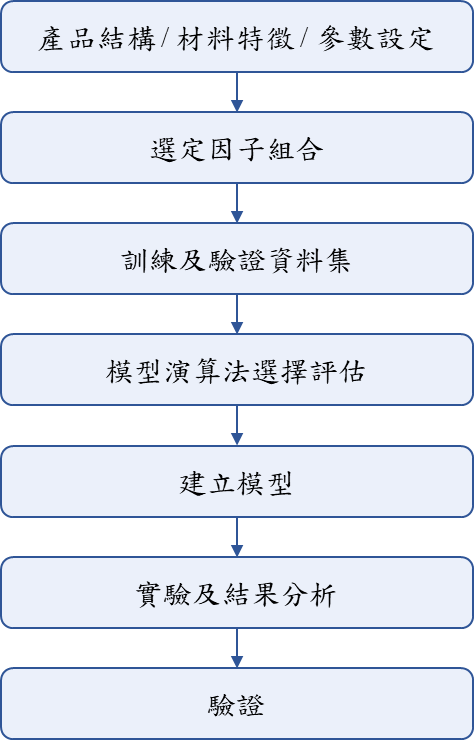
* 預測誤差值符合規格 : 從11% 提升至60%
* NPI額外生產成本 : 降低50%
* 實驗結果時間 : 降低50%
* RA form風險等級評估不再只有高風險和低風險兩個層級，根據不同風險情境更準確地識別和應對潛在風險

## 3-3模型設計

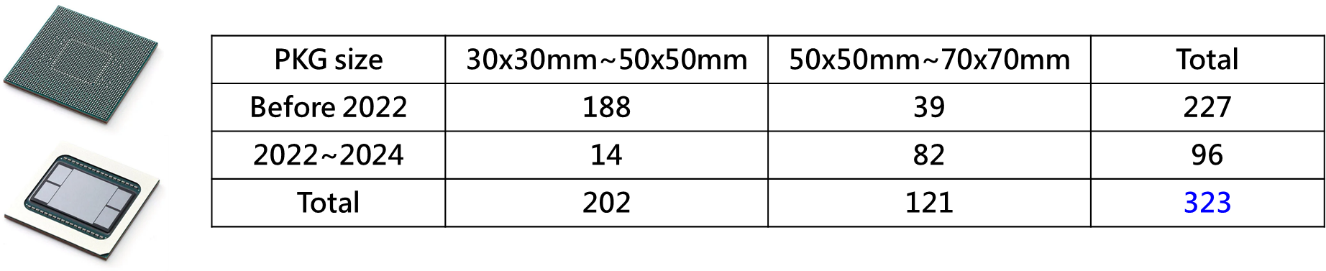
　　模型流程設計的初步階段，首先訂定實驗數據，並針對結構、材料及參數三大關鍵蒐集，以產品歷史資料進行模型建構的輸入，確認因子選定後，我們檢視是否需要做資料前處理，並對資料進行必要的清洗與標準化處理，確保數據的一致性和準確性。隨後將產品(Device) 中的20% 作為驗證資料，用於後續的模型驗證。

根據文獻探討之結果，選擇四種演算法建立機器學習模型，透過模型指標得出最佳方法，並進一步優化學習過程，以提高模型的準確性和預測能力。

最終，模型訓練完成後，進行驗證，將預測結果與實際數據進行比對，確認模型是否達到預期的KPI目標值，確保其實際應用中的可行性和效能。



### 3-3-1 Device資料集



依照產品結構大小(PKG size) 進行分類蒐集，生產履歷撈取出長度範圍介於30x30到70x70，30x30以下之產品較不會造成Coplanarity fail的情況發生，而70x70以上之產品在廠內數過少，若納入訓練資料中會使參考性較低，統計出Device數有323筆，原始資料數有64548筆，並以量產批(N) 為主要。

### 3-3-2資料(X)特徵、(Y)目標

　　製程中影響產品品質和性能的關鍵因子可從三大主要方向進行探討：產品結構(Structure factor)、材料差異(Material factor) 以及製程參數(Process parameters)，共24個關鍵因子。依據傳統預測方式，通過整合過往的經驗和實驗數據等因素，預測問題與風險要因。



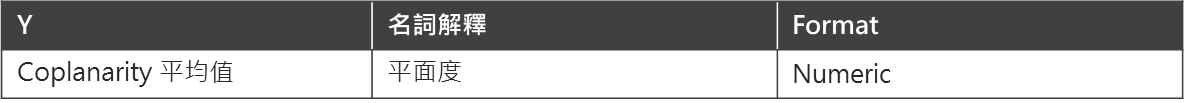
首先，產品結構是指晶片與基板之間的設計與組織，其中主要為大小及厚度。晶片和基板之間的結構設計影響著整體封裝的機械強度和穩定性。



選定的材料根據前中後製程的需求有所不同，特別是在覆晶封裝(Flip Chip) 中，常見的材料包括，助焊劑(Flux)、環氧樹脂(Epoxy)、膠(Tape)、壓模(Compound)、錫球(Solder ball)、錫膏(Solder paste)…等。這些根據其特性及應用領域可分為四大特徵因子，由於晶片與基板的直接接觸，正確的材料組合可有效降低應力集中，確保產品的長期穩定性與可靠性。



溫度為參數主要選定方向，後段製程因CTE Mismatch所引發Coplanarity fail的問題為本次探討的要因。



最後Y為本次主題Coplanarity。

### 3-4 AI方法論評估指標

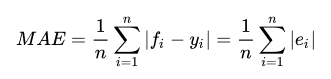
　　回歸指標(Regression metrics) 中 Bias(偏差)、Variance(變異) 為評估模型的預測性能。

Bias指的是模型預測值與真實值之間的差距，高Bias表示模型對訓練數據的擬合不夠，通常是因為模型過於簡單，無法捕捉數據中的複雜性，為欠擬合(underfitting)。

Variance指的是模型對不同訓練數據集的敏感程度，高Variance異意味著模型過於複雜，對小的數據波動過度反應，這可能會使模型在訓練數據上表現很好，但在新的數據或測試數據上表現較差，導致過擬合(overfitting)。

### 3-4-1平均絕對誤差(MAE, Mean Squared Error)

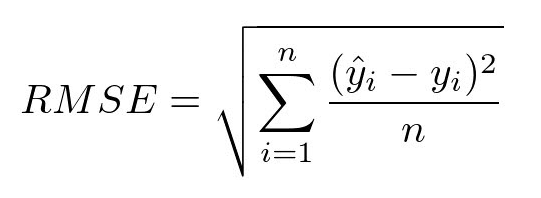
　　MAE是衡量模型預測值與實際值之間的誤差大小，即平均距離，對所有預測誤差賦予相同的權重，其計算方法是對所有預測誤差的絕對值求平均，因此對誤差的正負不會進行抵消，能夠更準確地反映誤差的整體情況。fi 表預測值，ŷi 表真實值，ei 表 | fi – yi | 的絕對誤差。



* 範圍 : 大於或等於0，越接近0時，表示模型準確度越高，表現越好。
* 特徵 : 由於是絕對誤差而非平方誤差，對異常值、離群值的影響較小。

### 3-4-2均方根誤差(RMSE, Root Mean Square Error)

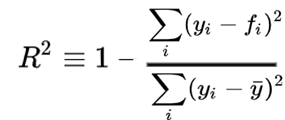
　　RMSE是預測值與實際值之間的誤差平方後取平均再做開根，得到預測誤差的平均大小，強調模型在處理大誤差時的表現，對誤差的平方進行加權，幫助識別出異常或離群值，能夠顯示出模型是否能有效控制大的預測誤差。



* 範圍 : 大於或等於0，越小，表示模型準確度越高。
* 特徵 : 對離群值敏感，適合用來進行梯度計算。

### 3-4-3決定係數(R2, R-Squared)

　　R²是衡量模型預測值與實際值之間誤差的變異程度，即模型對資料擬合的好壞，並以百分比形式呈現。值接近1表示擬合度高，若值為負表示模型並未有效解釋數據中的變異。



* 範圍 : 從0到1，越接近1，可解釋變異越高。
* 特徵 : 可以評估模型是否具有解釋性。

綜合模型性能可以更全面地了解模型的預測誤差和解釋能力，捕捉不同類型的誤差，不依賴其中指標，避免出現欠擬合及過擬合的情形發生。

# 第四章 實驗結果與驗證

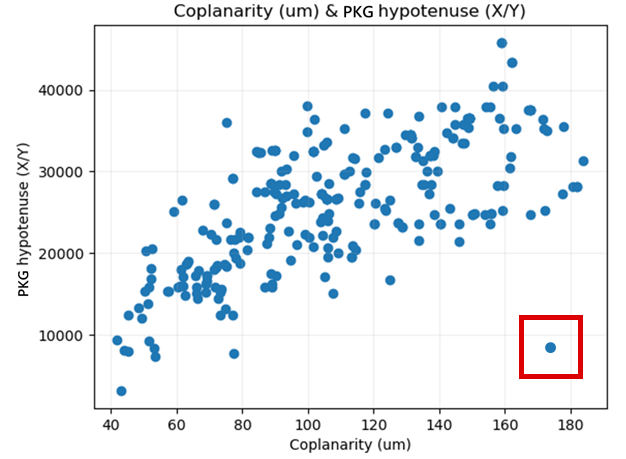
## 4-1 模型評估與分析

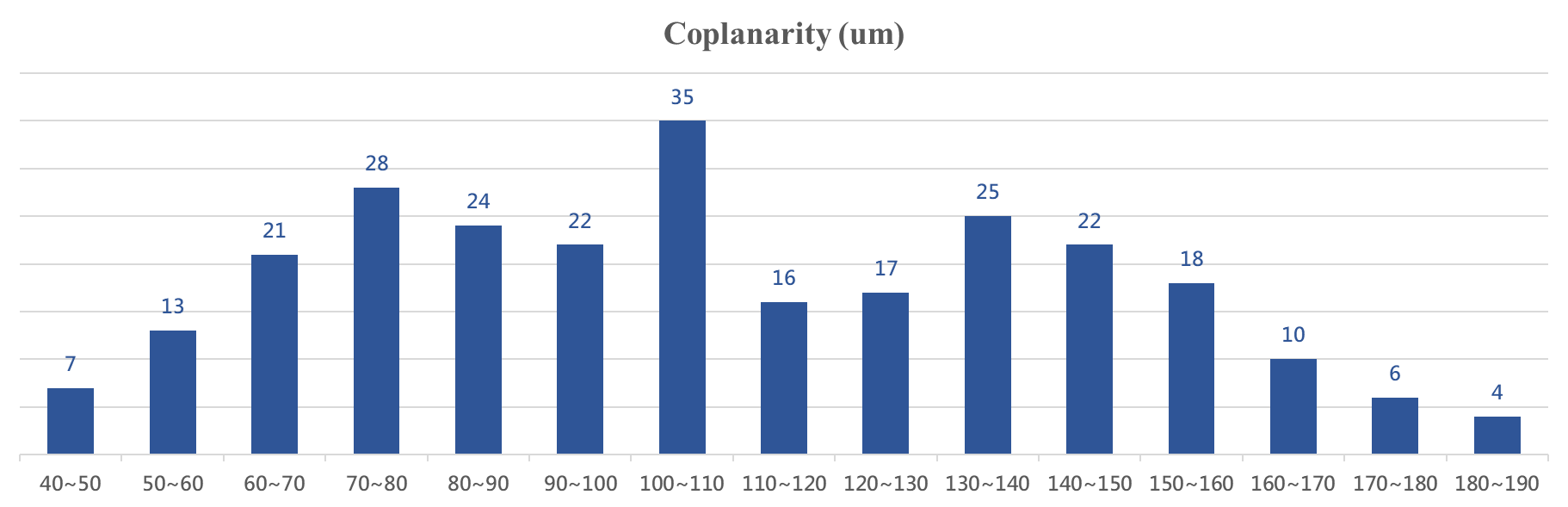
以2-4演算法與3-4模型評估指標，針對3-3-1 Device資料集323筆進行訓練及驗證，最後確認資料特徵因子之重要度，是否可解釋性分析。

1. 模型訓練資料 : 323

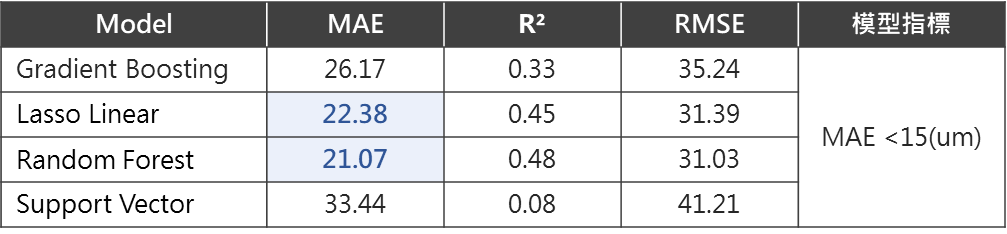


實驗結果MAE誤差值過高，經分布圖顯示結果，進行資料面處理。第一點將針對因過高的Coplanarity而導致資料偏差的現象，透過剔除離群值以降低誤差影響。第二點將移除系統中存在缺失值的因子筆數，為了避免插補缺失值後，使變數的解釋性變差，最後比數刪減至293筆。

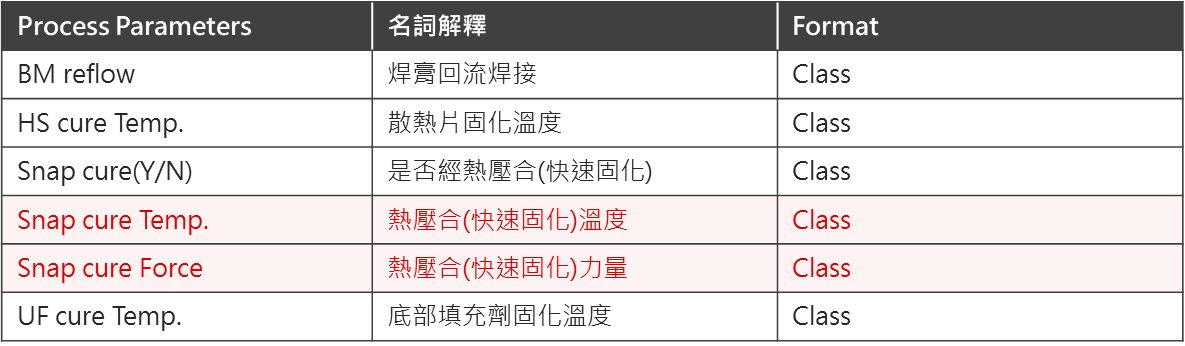




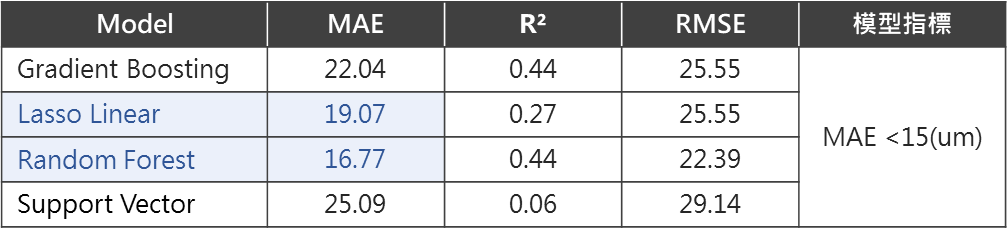
1. 模型訓練資料 : 293



Lasso Linear、Random Forest在指標MAE中都有降低的趨勢。重新在重要參數溫度做資料型態調整，Snap cure Temp / Force從Numeric調整成Class，在本研究中，Snap cure Temp / Force原始數據為連續型變數，然而Snap cure對平面度的改善效果並非線性變化，而是具有特定的影響區間，因此將這兩項因子由Numeric轉換為Class，並去除重複性的資料，以更好的捕捉其對結果變數的影響模式。

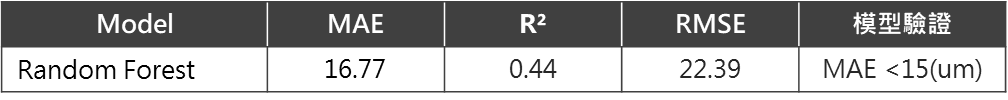


1. 模型訓練資料 : 263

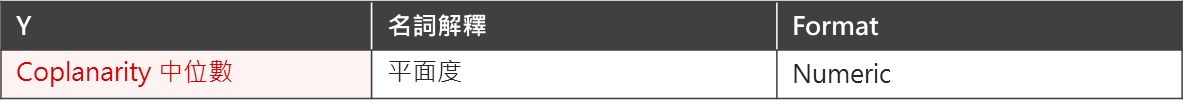


訓練結果Random Forest仍為最佳演算法，本研究將用Random Forest進行下一步優化以達指標及模型驗證。

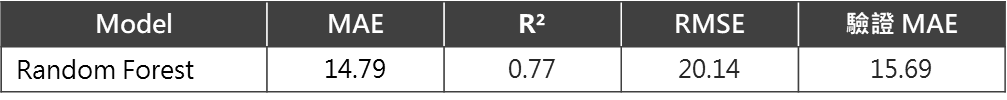
1. 模型訓練資料 : 263



回顧Coplanarity生產履歷資訊，數據呈現偏態分佈(Skewed distribution)，為避免即大部分樣本的Coplanarity值較低，但少數樣本的Coplanarity值極高，使其偏離大多數樣本的典型水準，平均值可能落在沒有實際樣本的區域。本研究將數據的代表值從平均值改為中位數，提高模型的泛化能力(Generalization)，使統計結果更具代表性。



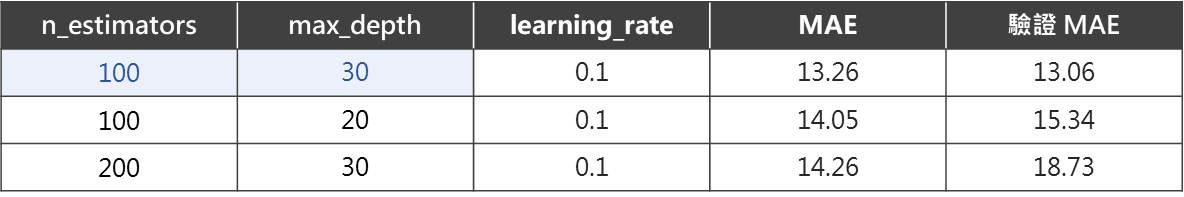
1. 模型訓練資料 : 210 / 模型驗證資料 : 53



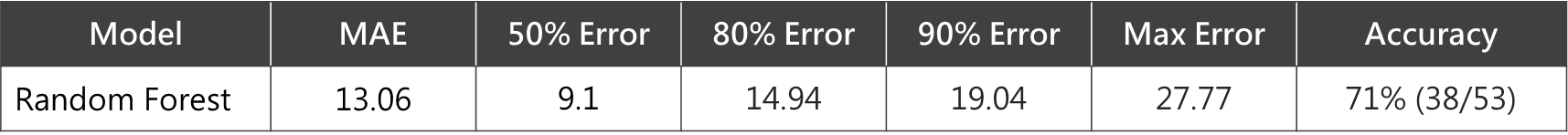
驗證結果與目標MAE diff.為0.69，合格件數百分比Accuracy(MAE <15um) 為57% (30/53)，調整超參數以達KPI指標。

1. 模型訓練資料 : 210 / 模型驗證資料 : 53

估算器數量(n\_estimators)、最大深度(max\_depth)、學習率(learning\_rate)

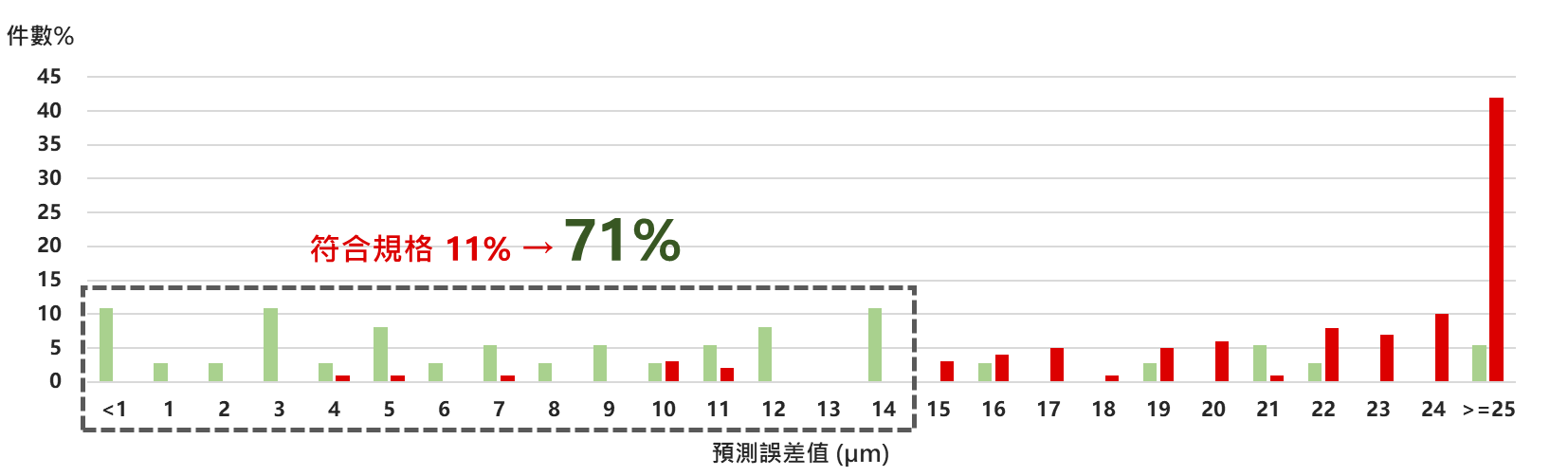
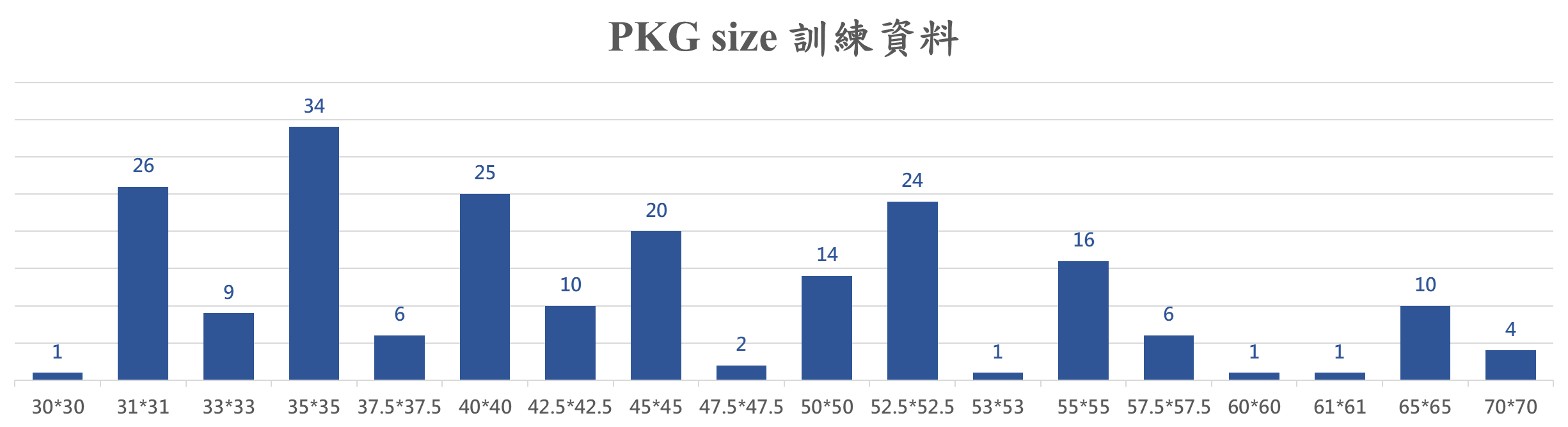
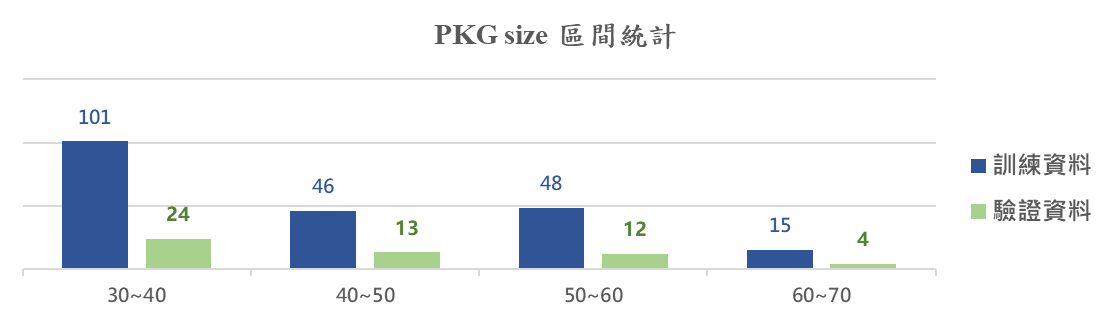


結果顯示，第一組參數能有效降低MAE，使模型具備良好的預測能力。最終模型驗證結果如下表。



## 4-2 實驗結果

相較傳統人工經驗與實驗室測試方式，即經多次預測仍有過大誤差，本研究透過模型導入，訓練資料經樣本數調整，樣本區間如圖、特徵因子Format轉換、以及超參數設定，使最終驗證結果MAE為13.06，Accuracy 結果為71%，與設置的KPI指標60% 多提升11%，已達此研究目標，如圖。使用AI模型導入此方法可證實其在高變異製程條件下，具備更強的非線性關聯捕捉能力與預測穩定性，不僅有效降低平面度預測誤差，更提升整體製程品質良率與效率。



## 4-3 模型導入

# 第五章 結論

　　針對特殊拋光製程DPEG在作業中仍存在著晶圓焦黑、拋光不完全及晶圓破片等製程缺點，進而造成產品良率下降和產能降低。在利用田口實驗法的實驗設計下，DPEG製程產生的缺點模式發生頻率有顯著的降低；在本研究下，可相信這些不穩定的因素已有一定幅度的改善。

　　利用田口實驗法中的關鍵因子選擇、少量試驗及統計分析，以降低成本同時求出最佳化參數，使得製程品質及良率獲得大幅的改善。根據本研究結果，總結了以下幾點:

1. 使用較薄的340(um)膠膜可以降低拋光作業時的晃動，因為340(um)膠膜厚度較薄，不易產生慣性力，在研磨過程中減少了機台震動的可能性，進而提高了機台作動的穩定性。此外，較薄的膠膜還可以提高拋光作業的精度，因為它可以更好地貼合在晶圓表面，減少了拋光時的間隙，進而提高了拋光的均勻性和一致性。
2. 較傾斜的工作盤角度(60°)增加拋光作業時機台的排屑能力，拋光產生的粉塵不易堆積在拋光輪齒邊緣，使拋光作業能穩定進行，不易產生忽大忽小的電流。
3. 較小的第一段壓力可以提高拋光的品質和穩定性。這是因為拋光初期過大的拋光壓力容易引起拋光時的摩擦熱和磨損，降低初始壓力亦可以減少拋光時的排屑量，延長拋光膠膜的使用壽命，減少拋光成本。
4. 影響拋光的因素是多方面的，本研究僅針對膠膜厚度、拋光初始壓力及工作盤角度這三個因子下去做探討，建議後續研究者能納入更多其他的關鍵因子。
5. 是否能開發出同樣具有離子吸附效果的研磨輪以代替DPEG的拋光輪，由於DPEG拋光輪成本較高
6. ；意即將Z3製程移除，保留Z1與Z2，並提高Z2的番數，這樣既可達到節省製程時間亦可達到省料。

# 第六章 參考文獻

1. Power & Beyond - Introduction to semiconductor manufacturing，2023-09-13
2. 周建宏，應用相移干涉法作BGA共平面度檢測，碩士論文，2000
3. 張翔昱，覆晶載板之機械性質對構裝體熱變形影響：量測與分析，碩士論文，2008
4. PBGA 與T -BGA 之共面性研究，from <http://csml9.pme.nthu.edu.tw/pdf/members/graduated/PBGAT2-B.pdf>
5. A Measurement Method that Solves Problems in Coplanarity Inspection，from

<https://www.keyence.eu/ss/products/microscope/measurement-solutions/coplanarity.jsp>

1. <https://kilong31442.medium.com/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E4%B8%AD%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E7%9A%8410%E7%A8%AE%E6%BC%94%E7%AE%97%E6%B3%95-407e4af47584>
2. <https://aws.amazon.com/tw/what-is/machine-learning/>
3. Hyung Gi Lee, Jung Min Sohn. "A Comparative Analysis of Buckling Pressure Prediction in Composite Cylindrical Shells Under External Loads Using Machine Learning. " MDPI Journal of Marine Science and Engineering (JMSE). December 2024 12(12):2301
4. Chris Thornton . "New power modules improve surfacemount manufacturability." <https://www.ti.com/lit/an/slyt212/slyt212.pdf?ts=1729430775521>
5. Hsu, Y. C. & Huang, W. S. (2024). "An Approach of Zero-Escape Anomaly Detection for Industrial Inspection Application. " In 2024 24th AOI Forum.
6. Hsu, Y. C., Wang, J. T., Wang, N.J., Kuo, P. Y, & Huang, W. S. (2022). "Two-stage Collaborative Deep Learning for Package Substrate Defect Detection. " In 2022 22th AOI Forum.
7. George A. Riley, PhD. "Controlling Pressure for Coplanarity & Bonding  in Flip Chip Assembly." <https://www.circuitnet.com/news/uploads/1/Controlling_Pressure_for_Coplanarity_and_Bonding_for_Flip_Chip.pdf>
8. Beth Yam Wei Yin. "Controlling Pressure for Coplanarity & Bonding  in Flip Chip Assembly." 2007 9th Electronics Packaging Technology Conference. IEEI, 07 March 2008
9. <https://vos.tier.org.tw/ArticleMore.aspx?DGUID=a646d4c4-d66f-4567-9be2-2a8c581c9f7f>
10. M.Y. Tsai. "Thermal deformations and stresses of flip-chip BGA packages with low- and high-Tg underfills." IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing 28(4):328 – 337
11. Ming-Che Hsieh. "Advanced Flip Chip Package on Package Technology for Mobile Applications." Originally published in the 17th International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT) 2016, Wuhan, China, Aug 16 – 19, 2016.
12. Laurene Yip, Raghunandan Chaware. "Overmolded flip chip packaging solution for large die FPGA with 65nm low-k dielectrics." 2007 12th International Symposium on Advanced Packaging Materials: Processes, Properties, and Interfaces. IEEI, 03-05 October 2007
13. <https://www.ansys.com/content/dam/amp/2022/july/quick-request/2022-ansys-taiwan-brochure.pdf>
14. John Davignon, Ken Chiavone, Jiahui Pan, James Henzi, David Mendez, Ron Kulterman. "An Investigation into the Predictability of PCB Coplanarity for Room vs. Lead Free Assembly Temperatures." iNEMI SMT Coplanarity WG
15. Ho-Yi Tsai, Jeff Huang, Steve Chiu, C.S. Hsiao. "High Performance Molding FCBGA Packaging Development." 2007 8th International Conference on Electronic Packaging Technology. IEEI, 28 January 2008
16. Kahtan A Mohammed. "Synergizing ANSYS Simulations and Machine Learning for Transient Thermal Analysis in Aluminium Alloys. " March 2024 E3S Web of Conferences 507:01058
17. Jair Cervantes, Farid García-Lamont, Lisbeth Rodríguez, Asdrubal Lopez-Chau. "A comprehensive survey on support vector machine classification: Applications, challenges and trends." May 2020 Neurocomputing 408(07)
18. Ernest Yeboah Boateng, Joseph Otoo, Daniel A. Abaye. "Basic Tenets of Classification Algorithms K-Nearest-Neighbor, Support Vector Machine, Random Forest and Neural Network: A Review." Journal of Data Analysis and Information Processing 08(04):341-357
19. Malti Bansal, Apoorva Goyal, Apoorva Choudhary. "A comparative analysis of K-Nearest Neighbor, Genetic, Support Vector Machine, Decision Tree, and Long Short Term Memory algorithms in machine learning." May 2022 Decision Analytics Journal 3(11):100071
20. Dazhong Wu, Connor Jennings, Janis Terpenny, Robert X. Gao, Soundar Kumara. "A Comparative Study on Machine Learning Algorithms for Smart Manufacturing: Tool Wear Prediction Using Random Forests." J. Manuf. Sci. Eng. Jul 2017, 139(7): 071018
21. Hsu, Y. C., & Huang, W. S. (2023, October). "A Precision Enhancement Deep Learning Framework for Package Substrate Defect Detection. " In 2023 18th International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology Conference (IMPACT) (pp. 174-177). IEEE.
22. Hsu, Y. C., Kuo, P. Y., & Huang, W. S. (2019, October). "A novel feature-spanning machine learning technology for defect inspection. " In 2019 14th International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology Conference (IMPACT) (pp. 54-57). IEEE.
23. Ying Yu, Feng Yu, Yanru He, Wenwen Yang. "A Hybrid Fuzzy Random Forest Algorithm Using Harmonic Search Algorithm for Parameter Tuning." 2021 IEEE International Conference on Advances in Electrical Engineering and Computer Applications (AEECA). IEEI, 02 November 2021
24. Corinna Niegisch, Sabine T. Haag, Tanja Braun, Ole Hülck, Martin Schneider-Ramelow. "Application of Machine Learning Methods for Process Optimization in Electronic Packaging Processes." 2023 24th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition (EMPC). IEEI, 09 February 2024
25. K. Anupama Francy, Ch. Srinivasa Rao. "A framework for prediction of extrusion responses using machine learning algorithm. " December 2024 International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)
26. Yuda Li, Daoguo Yang, Chenwen Qin, Minghua Xie, Zhiliang Hu, Shenhuai Feng. "Small Sample Data-Driven Multi-Objective Optimization of MEMS Sensor Molding Process Parameters." 2024 25th International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT). IEEI, 23 September 2024
27. <https://www.cupoy.com/qa/club/ai_tw/0000016D6BA22D97000000016375706F795F72656C656173654B5741535354434C5542/0000017B7B636BB1000000266375706F795F72656C656173655155455354>
28. <https://chih-sheng-huang821.medium.com/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E7%B5%B1%E8%A8%88%E6%96%B9%E6%B3%95-%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E8%A9%95%E4%BC%B0-%E9%A9%97%E8%AD%89%E6%8C%87%E6%A8%99-b03825ff0814>
29. <https://www.ctci.org.tw/media/9685/ai%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%A3%BD%E9%80%A0%E8%88%87%E6%95%B8%E4%BD%8D%E8%BD%89%E5%9E%8B.pdf>
30. <https://datascience.eu/machine-learning/gradient-boosting-what-you-need-to-know/>
31. Anjani Kumar. "Introduction to the Gradient Boosting Algorithm. " May 21, 2020, from

<https://medium.com/analytics-vidhya/introduction-to-the-gradient-boosting-algorithm-c25c653f826b>